

Japanese Utility Model Laid-Open Number : 57945/91

Date of publication of Application : June 5, 1991

Application Number: 118588/89

Date of filing : October 9, 1989

Applicant: Mitsubishi Material Kabushiki Kaisha

Title of the Invention: Base plate light in weight for semiconductor device

ABSTRACT:

A base plate light in weight for a semiconductor device comprises a heat sink plate of Al or Al alloy, a sintered insulating plate of aluminum nitride bonded on the heat sink plate by a brazing material of Al-Si alloy or Al-Ge alloy, and a thin plate for forming a circuit bonded on the insulating plate by a brazing material of Al-Si alloy or Al-Ge alloy, a predetermined surface portion or entire surface of the thin plate being plated with a layer of Cu or Ni.

公開実用平成3-5745

⑩日本国特許庁 (JP)

⑪実用新案出願公開

⑫公開実用新案公報 (U) 平3-57945

⑬Int. Cl. 3

H 01 L 23/36

識別記号

庁内整理番号

⑭公開 平成3年(1991)6月5日

7220-5F H 01 L 23/36

C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑮考案の名称 半導体装置用軽量基板

⑯実 願 平1-118588

⑯出 願 平1(1989)10月9日

⑰考案者 吉田 秀昭 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究所内

⑰考案者 黒光 祥郎 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究所内

⑰考案者 鳥海 誠 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究所内

⑰考案者 湯澤 通男 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究所内

⑯出願人 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

⑰代理人 弁理士 富田 和夫 外1名



明細書

1. 考案の名称

半導体装置用軽量基板

2. 実用新案登録請求の範囲

(1) いずれも Al または Al 合金からなるヒートシンク板材および回路形成用薄板材のそれぞれで、窒化アルミニウム系焼結体からなる絶縁板材を両側からはさんだ状態で、Al - Si系合金またはAl - Ge系合金のろう材を用いて積層接合してなり、かつ前記回路形成用薄板材の表面の所定部分または全面に Cu または Ni メッキ層を形成してなる半導体装置用軽量基板。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は、軽量にして、半導体装置の高集積化および大電力化に十分対応することができる基



板に関するものである。

(従来の技術)

従来、一般に、半導体装置用基板としては、例えば第2図に概略説明図で示されるように、酸化アルミニウム (Al_2O_3 で示す) 焼結体からなる絶縁板材 C' の両側面に、それぞれ Cu薄板材 B' を液相接合し、この液相接合は、例えば前記 Cu薄板材の接合面に酸化銅 (Cu_2O) を形成しておき、前記 Al_2O_3 焼結体製絶縁板材と重ね合せた状態で、1065～1085°Cに加熱して接合面に前記 Cu_2O と Cu との間で液相を発生させて結合することからなり、また前記 Cu薄板材のうち、前記絶縁板材 C' の一方側が回路形成用導体となり、同他方側がヒートシンク板材 A' とのはんだ付け用となるものであり、この状態で、通常 Pb-Sn合金からなるはんだ材 (一般に450°C以下の融点をもつものをはんだという) D' を用いて、Cuからなるヒートシンク板材 A' に接合してなる構造のものが知られている。

〔考案が解決しようとする課題〕

しかし、近年の半導体装置の高集積化および大電力化に伴って、装置自体が大型化し、重量化する傾向にあり、したがってこれを構成する部材の軽量化が強く望まれているが、上記の従来半導体装置用基板では、これを構成するヒートシンク板材A'および薄板材B'がいずれも重質のCuであり、さらにこれに重質のPb-Sn合金はんだ材D'が加わるために、これらの要求に対応することができないのが現状である。

〔課題を解決するための手段〕

そこで、本考案者等は、上述のような観点から、軽量な半導体装置用基板を開発すべく研究を行なった結果、ヒートシンク板材および薄板材を、純Alや、例えばAl-2.5%Mg-0.2%Cr合金およびAl-1%Mn合金などのAl合金で構成し、これをAl₂O₃焼結体に代えて窒化アルミニウム（以下AlNで示す）系焼結体とした絶縁板材の両面に、Al-13%Si合金、Al-7.5%Si合金、Al-9.5%Si-1%Mg合



金、およびAl-7.5%Si-10%Ge合金などのAl-Si系合金や、Al-15%Ge合金などのAl-Ge系合金からなるろう材（以上重量%）を、箔材、あるいは前記ヒートシンク板材および薄板材の接合面側にクラッドした状態で用いて、積層接合し、かつ前記薄板材の表面の所定部分または全面に回路形成用および部品はんだ付け用としてCuまたはNiメッキ層を形成した構造にすると、構成部材すべてが軽量のAlおよびAl合金とAlN系焼結体で構成されることになることから、基板全体が軽量化されたものになるという知見を得たのである。

この考案は、上記知見にもとづいてなされたものであって、第1図に概略説明図で示されるように、いずれもAlまたはAl合金からなるヒートシンク板材Aおよび回路形成用薄板材Bのそれぞれで、AlN系焼結体からなる絶縁板材Cを両側からはさんだ状態で、Al-Si系合金またはAl-Ge系合金のろう材Dを用いて積層接合してなり、かつ前記回路形成用薄板材Bの表面の所

定部分または全面に Cu または Ni メッキ層を形成してなる半導体装置用軽量基板に特徴を有するものである。

〔実 施 例〕

つぎに、この考案の半導体装置用基板を実施例により具体的に説明する。

幅 : 50mm × 厚さ : 0.63mm × 長さ : 75mm の寸法をもち、かつ重量%で 95% AlN - 5% Y_2O_3 の組成をもった AlN 系焼結体からなる絶縁板材 C、いずれも第 1 表に示される組成の AlN または Al 合金からなり、かつ寸法が幅 : 50mm × 厚さ : 3mm × 長さ : 75mm のヒートシンク板材 A と、同じく幅 : 45mm × 厚さ : 1mm × 長さ : 70mm の薄板材 B、同じく第 1 表に示される組成を有する厚さ : 50 μ m の箔材とした Al - Si 合金および Al - Ge 合金からなるろう材 D、さらに第 1 表に示される組成を有するろう材を上記のヒートシンク板材 A および薄板材 B の圧延加工時に 30 μ m の厚さにクラッシュしてろう付け板材（プレージングシート）とした上記寸法のヒートシンク板材および薄板材を



種別	ヒートシンク板材の組成(重量%)	薄板材の組成(重量%)	ろう成形材		割れ発生までのサイクル数	熱伝導度(W/m・K)	重量
			形状	組成(重量%)			
本 考 案 基 板	純 Al	純 Al	角材	Al - 13% Si 合金	159	0.354	
	Al - 2.5% Mg - 0.2% Cr 合金	純 Al	角材	Al - 7.5% Si 合金	132	0.353	
	Al - 1% Mn 合金	Al - 1% Mn 合金	角材	Al - 15% Ce 合金	135	0.353	
	純 Al	純 Al	角材	200 サイクル	140	0.353	
	Al - 1% Mg 合金	Al - 1% Mg 合金	角材	Al - 9.5% Si - 1% Mg 合金	後も割れ	150	0.352
	純 Al	純 Al	角材	1% Mg 合金	発生せず	158	0.352
	Al - 1% Mn 合金	Al - 1% Mn 合金	角材	Al - 7.5% Si - 10% Ce 合金		146	0.352
	Al - 0.02% Ni 合金	Al - 0.02% Ni 合金	角材	Al - 7.5% Si 合金		139	0.352
	Al - 0.005% B 合金	Al - 0.005% B 合金	角材	Al - 7.5% Si 合金		157	0.354
	従来基板	従来基板			20	160	1

第 1 表



それぞれ用意し、ついでこれらを第1図に示される状態に積み重ね、この状態で真空中、430～610℃の範囲内のろう材の溶融温度に適合した温度に10分間保持の条件でろう付けして積層接合体とし、この積層接合体に、温度：350℃に30分間保持後常温まで炉冷の熱処理を施し、引続いて前記積層接合体を構成する薄板材Bの表面全面に、厚さ：0.5μmのCuまたはNiメッキ層を通常の無電解メッキ法により形成することにより本考案基板1～10をそれぞれ製造した。

また、比較の目的で、第2図に示されるように、幅：50mm×厚さ：0.63mm×長さ：75mmの寸法をもった純度：96%のAl₂O₃焼結体からなる絶縁板材C'を用い、これの両側から幅：45mm×厚さ：0.3mm×長さ：70mmの寸法をもった無酸素銅薄板材B'（2枚）ではさんだ状態で重ね合わせ、この状態で酸素：1容量%含有のAr雰囲気中、温度：1075℃に50分間保持の条件で加熱し、この酸化性雰囲気で表面に形成したCu₂Oと母材のCuとの共晶による液相を接合面に発生させて接



合し、ついでこの接合体を、厚さ:300μmの箔材とした Pb-60% Sn合金からなるはんだ材D'を用いて、幅:50mm×厚さ:3mm×長さ:75mmの寸法をもった無酸素銅からなるヒートシンク板材A'の片面にはんだ付けすることにより従来基板を製造した。

ついで、本考案基板1~10および従来基板について、一般に半導体装置用基板の評価試験として採用されている試験、すなわち温度:125°Cに加熱後、-55°Cに冷却を1サイクルとする繰り返し加熱試験を行ない、絶縁板材に割れが発生するに至るまでのサイクル数を20サイクル毎に観察して測定し、またレーザ・フラッシュ法にて熱伝導度を測定し、さらに本考案基板1~10の重量を測定し、従来基板の重量を1とし、これに対する相対比を求めた。これらの結果を第1表に示した。

[考案の効果]

第1表に示される結果から、本考案基板1~10は、いずれも従来基板と同等のすぐれた熱伝導性を示し、かつ苛酷な条件下での加熱・冷却の繰り



返しによっても、絶縁板材に割れの発生が見られないのに対して、従来基板では Al_2O_3 焼結体絶縁板材と Cu薄板材間の大きな熱膨張係数差に原因して絶縁板材に比較的早期に割れが発生するものであり、また本考案基板1~10は、従来基板に比して約65%の重量減を示し、軽量化の著しいことが明らかである。

上述のように、この考案の半導体装置用基板は、軽量なので半導体装置の高集積化および大電力化に十分対応することができ、かつ苛酷な条件下での実用に際してもセラミック質の絶縁板材に割れなどの欠陥発生なく、信頼性のきわめて高いものであるなど工業上有用な効果をもたらすものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案の半導体装置用基板の概略説明図、第2図は従来半導体装置用基板の概略説明図である。

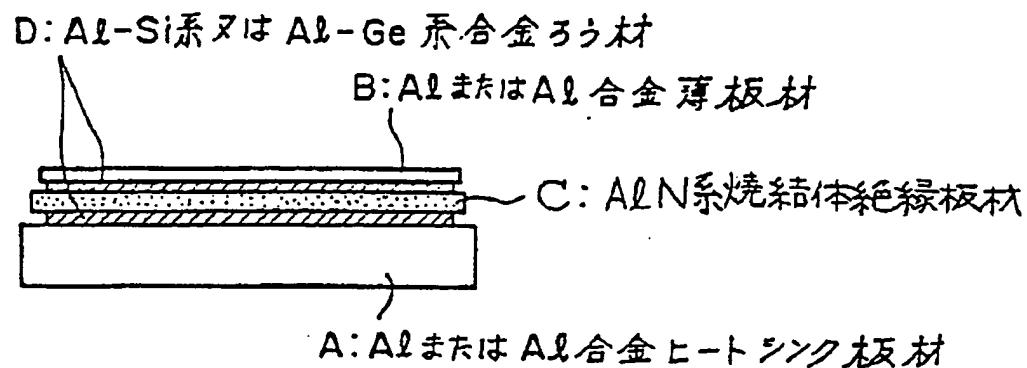
A, A' … ヒートシンク板材、



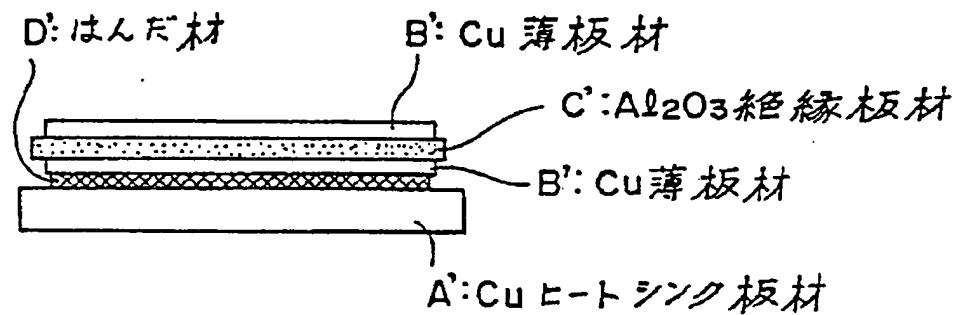
B, B' … 薄板材、 C, C' … 絶縁板材、
D … ろう材、 D' … はんだ材。

出願人：三菱金属株式会社

代理人：富田和夫 外1名



第1図



第2図

手 続 補 正 書 (自発)

平成 2年 4月 23日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

実願平1-118588号



2. 考案の名称

半導体装置用軽量基板

3. 補正をする者

事件との関係 実用新案登録出願人

住所 東京都千代田区大手町一丁目5番2号

氏名(名称) (626) 三菱金属株式会社

代表者 永野 健

4. 代理人

住所 東京都千代田区神田錦町一丁目23番地

宗保第二ビル8階

〒101 電話(03)233-1676・1677

氏名 弁理士(7667) 富田 和夫



5. 拒絶理由通知の日付

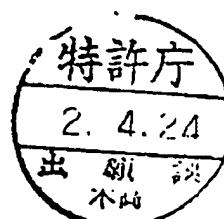
自発

6. 補正の対象

明細書の考案の詳細な説明の欄

7. 補正の内容 別紙の通り

方式
審査



573

1003-57045

(1) 明細書、考案の詳細な説明の項、第5頁、
第9行、

「からなる絶縁板材」とあるを、
「からなり、さらに主成分としてNaOHを
6%含有の液温：60℃のアルカリ性水溶液
中に30分間浸漬の条件でエッチング処理を
施して表面粗さを25S（JIS規格）に粗
面化した絶縁板材」と訂正する。

以上

THIS PAGE BLANK (USPTO)